



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HX3906

对应国外型号
2N3906

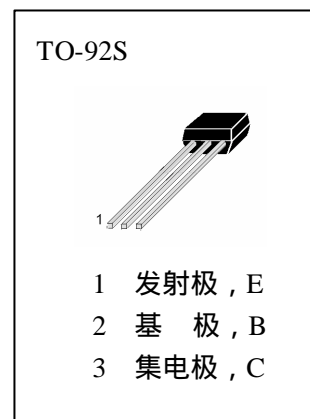
主要用途

小信号放大、高频振荡、开关应用。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极耗散功率.....	300mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	-40V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	-40V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	-5V
I_C	——集电极电流.....	-200mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-40			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-40			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-30V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	70		350		$V_{CE}=-1V, I_C=-10mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.25	V	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			-0.85	V	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$
fT	特征频率	300			MHz	$V_{CE}=-20V, I_C=-10mA$ $f=100MHz$

分档及其标志

A	B
70—240	220—350